

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-035806

(43)Date of publication of application : 09.02.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/268
H01L 21/20
H01L 27/12
H01L 29/786
H01L 21/336

(21)Application number : 11-207128

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 22.07.1999

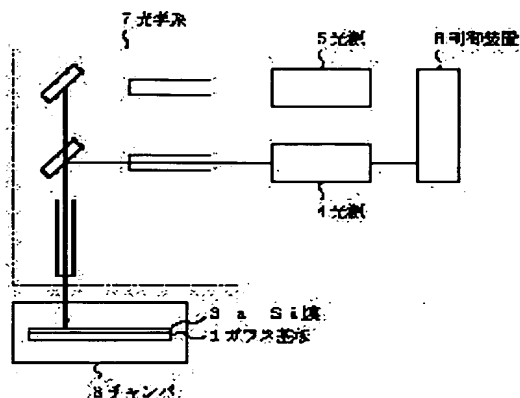
(72)Inventor : OKUMURA NOBU

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR THIN FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To create at a high throughput on a large substrate a highly uniform semiconductor thin film having a high electron-mobility, by projecting the double pulses of a laser beam on the non-single-crystal semiconductor thin film, and by setting energy density in each pulse within the threshold of its fine-crystallization energy density caused by the projection of a pulse laser beam.

SOLUTION: After depositing as a cover film a silicon oxide film 2 on a glass substrate 1 by a plasma chemical vapor deposition method, an a-Si film 3 is deposited thereon. Then, a XeCl laser beam 50 having predetermined dimensions is projected on the a-Si film 3 to set the threshold of its fine-crystallization energy-density to, e.g. 470 mJ/cm². In this case, by synchronizing two light sources 4, 5 with each other through a controller 6, the double pulses of a laser beam are projected through an optical system 7 on the a-Si film 3 of the glass substrate 1 provided in a chamber 8. As the projective conditions of the double pulses of the laser beam, the energy densities of first and second laser beams are set respectively, e.g. to 400 mJ/cm² and 240 mJ/cm² to make them not larger than the threshold of the fine-crystallization energy-density of the a-Si thin film 3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3422290

[Date of registration]

25.04.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2001-35806
(P2001-35806A)

(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

(5)InCl.	識別記号	FI	チコード(参考)
H01L 21/268		H01L 21/268	F 5F052
21/20		21/20	5F110
27/12		27/12	R
29/78		29/78	627G
21/336			
審査請求 有 請求項の数 8 OL (全 7 頁)			

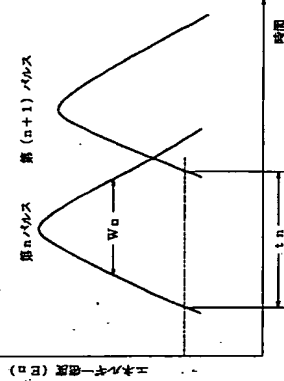
(21)出願番号	特開平11-207128	(71)出願人	00004237 日本電気株式会社
(22)出願日	平成11年7月22日(1999.7.22)	(72)発明者	奥村 展 東京都港区芝五丁目7番1号
		(74)代理人	100082835 弁理士 坂本 直樹 (外2名) Fターム(参考) 5F052 A02 B418 B007 D002 D002 D007 J401 5F110 D002 D013 G032 G013 G015 G043 G045 G047 P003

(54) 発明の名称 半導体薄膜の製造方法

(67) 要約

【課題】従来、液晶表示装置に搭載される TFT の半導体薄膜を大粒化するための技術においては、スルーブットが低下し、サブミクロンのステージ動作精度を確保するたため、均質に大粒化するという問題があるため、大面積に渡って均質に大粒化することは困難であった。

【解決手段】a-Si 膜に、n を 1 以上の整数、n 発目のパルスのエネルギー密度を E_n 、パルス幅を W_n 、n 発目と (n+1) 発目のパルス間隔を t_n とするとき、 $E_n > E_{n+1}$ 、 $t_n \leq 6W_n$ 、 $E_1 + E_2 + \dots + E_n + E_{n+1} > E_u$ の条件を満たす複数のパルスレーザを照射することにより、基板方向に短軸方向の 2 倍を超える粗大結晶粒が得られ、基板の広い範囲に渡って大きなスルーブットでスキャン照射することが可能となり、高いスルーブットが得られ、ステージ動作精度の緩和も可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 非単結晶半導体薄膜に複数のパルスレーザを逆照射して同一箇所を照射することにより多結晶又は単結晶半導体薄膜を製造する方法であって、各パルスのエネルギー密度が、前記非単結晶半導体薄膜のパルスレーザの照射により微結晶化するエネルギー密度しきい値を超えないことを特徴とする半導体薄膜の製造方法。

【請求項 2】 前記複数のパルスレーザの各パルスレーザのエネルギー密度は、前記非単結晶半導体薄膜がパルスレーザの照射により微結晶化するエネルギー密度しきい値よりも低く、逆照射する前記複数のパルスレーザの後のパルスレーザのうち、前のパルスレーザのエネルギー密度は後のパルスレーザの全てのエネルギー密度以上であり、前記複数のパルスレーザの全てのエネルギー密度の和が前記エネルギー密度しきい値を超える請求項 1 記載の半導体薄膜の製造方法。

【請求項 3】 前記前後のパルスレーザの照射間隔は、前記前後のパルスレーザの半価幅であるパルス幅の 6 倍以上である請求項 2 記載の半導体薄膜の製造方法。

【請求項 4】 前記前後のパルスレーザの照射間隔は、前記前後のパルスレーザの半価幅であるパルス幅の 1 倍以上 4 倍以下である請求項 2 記載の半導体薄膜の製造方法。

【請求項 5】 前記複数のパルスレーザの照射により前記多結晶又は単結晶半導体薄膜が、長軸方向の結晶粒の長さが短軸方向の結晶粒の長さの 2 倍を超え、かつ、前記結晶粒が前記短軸方向に列を成して並ぶ組織を含む請求項 1、2、3 又は 4 記載の半導体薄膜の製造方法。

【請求項 6】 前記非単結晶半導体薄膜に前記複数のパルスレーザを逆照射して同一箇所に行う照射が、前記非単結晶半導体薄膜の上を前記長軸方向の結晶粒の長さ以下 4 倍以上の前記長軸方向に移動して繰り返されるスキャン照射である請求項 5 記載の半導体薄膜の製造方法。

【請求項 7】 前記非単結晶半導体薄膜が、減圧化学気相成長 (LPCVD) 法、プラズマ化学気相成長 (PECVD) 法、スパッタ法のいずれかの方法により形成される請求項 1、2、3、4、5 又は 6 記載の半導体薄膜の製造方法。

【請求項 8】 前記多結晶又は単結晶半導体薄膜が、ガラス基板の上に形成される請求項 1、2、3、4、5、6 又は 7 記載の半導体薄膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】 本発明は非単結晶半導体薄膜にパルスレーザ光を照射してアニールを行う半導体薄膜の製造方法に関し、特に液晶ディスプレイや密着型イメージセンサ等の絶縁性基板上に形成される多結晶シリコン薄膜トランジスタの活性層を形成する、レーザアニール工程の構成に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、ポリシリコン (以下 polysi と記載する) 薄膜トランジスタの製造技術が適用することにより、安価なガラス基板上に駆動回路を備えた液晶表示装置を形成することが可能となっている。polysilicon は、シリコンの結晶化率を低く保ち、低抵抗化および高スルーブット化の観点から、エキシマレーザ光を照射することによりアモルファスシリコン (以下 a-Si と略称する) 薄膜を結晶化させて polysilicon (以下 polysi と略称する) 薄膜を得るエキシマレーザ結晶化法が用いられる。

【0003】 エキシマレーザ結晶化法の欠点として、レーザ光がパルスレーザ光であるために薄膜が熱処理される時間が限られてしまい、得られる結晶粒の大きさが制限されてしまうという問題がある。そのため polysilicon は、シリコントランジスタ (TFT) のキャリアの電界効果移動度が $100 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 程度に留まり、液晶表示装置等は実現できても、DRAM 等の高周波駆動の高集積回路は実現不可能であった。

【0004】 polysilicon 薄膜の大粒化技術の第 1 の技術としては、例えば、特開平 10-275781 号公報、或いは、第 4 回応用物理学会講演会講演要旨集第 2 分冊 694 頁 (若者、石原他) により開示されているように、複数のパルスレーザを合成して照射する技術が知られている。

【0005】 また、大粒化技術の第 2 の技術としては、例えば、MRS Bulletin 21 巻 (1996 年)、3 月号、39 頁 (若者、1 m 他) により開示されているように、基板に形成した非晶質シリコン薄膜に、幅 $5 \mu\text{m}$ の極めて微細な線状ビームを $0.75 \mu\text{m}$ ピッチでスキャン照射することにより、結晶粒がほぼ平行に整列している一方向成長多結晶シリコン薄膜を形成する技術が知られている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、大粒化技術の第 1 の技術においては、各レーザ照射領域においては、大粒化するための、液晶表示装置に用いられる数百ミリのメートル四方の面積の基板において、均質に大粒化を果すことは困難であった。又、大粒化技術の第 2 の技術においても、スルーブットが低下するといいう問題、サブミクロンのステージ動作精度を確保するための均質に大粒化するという問題が残る。

【0007】 本発明の目的は、上述の問題を鑑みてなされたものであって、高スルーブットで大面積基板上、高均一でかつ高移動度の半導体薄膜の作製方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 本発明の半導体薄膜の製造方法は、非単結晶半導体薄膜に複数のパルスレーザを逆照射して同一箇所を照射することにより多結晶又は単結晶半導体薄膜を製造する方法であって、各パルスのエネ

(3)

ルギー密度が、前記非単結晶半導体薄膜のバルスレーザの照射により微結晶化するエネルギー密度 E_u の値を超えないことを特徴とし、前記微結晶のバルスレーザの各パルスレーザのエネルギー密度は、前記非単結晶半導体薄膜がバルスレーザの照射により微結晶化するエネルギー密度 E_u の値より低く、逆接する前記微結晶のバルスレーザの照射後のバルスレーザのうち、前のバルスレーザのエネルギー密度は後のバルスレーザのエネルギー密度以上であり、前記微結晶のバルスレーザの全てのエネルギー密度の和が前記エネルギー密度 E_u の値を超え、前記前微結晶のバルスレーザの照射間隔は、前記微結晶のバルスレーザの照射間隔の6倍以上、前記後のバルスレーザの照射間隔は、前記微結晶のバルスレーザの照射間隔の1倍以上4倍以下である、というものである。

[0009] 又、前記微結晶のバルスレーザの照射により前記多結晶又は前記単結晶半導体薄膜が、長軸方向の結晶粒の長さ L が短軸方向の結晶粒の長さ W の2倍を超え、かつ、前記結晶粒が前記短軸方向に列を成して並ぶ組織を含み、前記非単結晶半導体薄膜に前記微結晶のバルスレーザを照射して同一箇所に行う照射が、前記非単結晶半導体薄膜の上を前記長軸方向の結晶粒の長さ L 以上のピッチで前記長軸方向に移動して繰り返されることを特徴とするものである。

[0010] 上記半導体薄膜の製造方法において、前記非単結晶半導体薄膜が、被圧化学気相成長 (LPCVD) 法、プラズマ化学気相成長 (PECVD) 法、スパッタ法、いずれかの方法により形成される、或いは、前記多結晶又は単結晶半導体薄膜が、ガラス基板の上に形成される、という形態をとることもできる、というものである。

[0011] [発明の要旨] 本発明の半導体薄膜の製造方法は、本発明が主張する基本的な構成について説明する前に、本発明の背景となる、結晶化現象について図3(a)を参照して説明しておく。

[0012] 非単結晶および多結晶薄膜などの単結晶構造でない薄膜を非単結晶薄膜というが、非単結晶薄膜の結晶化は、薄膜の溶融状態の変化により、再結晶化時の核発生機構が、基板薄膜界面を核発生サイトとした不均一核発生から、均一核発生へと変化するることにより、異なると考えられている。この核発生機構の変化は、薄膜の到達速度と冷却速度に依存する。

[0013] 非単結晶シリコン薄膜に、微結晶化しきい値 E_u を超えるエネルギー密度を有する図3(a)のようないくつかのバルスレーザの照射により、再結晶化されたとき、ビームプロファイル上の微結晶化しきい値 E_u の直下となる地点に粗大結晶粒が形成される。即ち、平面的な結晶粒分布を見ると、微結晶化領域9の隣接地点に粗大結晶粒10が形成される。従って、ビー

ムプロファイルが非単結晶シリコン薄膜の微結晶化しきい値以上のレーザ光を非単結晶シリコン薄膜に照射するとき、形成される結晶粒の数はおおよそ発生位置を一次元に制御することが可能となる。特にビーム後部81において形成される粗大結晶粒10を種結晶とし、その粒径以下でレーザ光をスキャンするとき、種結晶は溶け残り粗大結晶粒を含む多結晶組織は、その後のスキャン照射により微結晶化されるため、ビーム後部81で形成された種結晶の粒成長を妨げることがない。即ち、微結晶化現象を利用することにより、バルスレーザ光スキャン照射法における結晶組織の不均質性を回避することが可能となる。

[0014] ここで高スループットを得るためには、ビーム後部81で形成される種結晶の結晶粒径を拡大すれば良く、これには同一箇所内複数のバルスレーザを同期させてパルス幅程度の時間内に連続的に照射する、ダブルパルス法が有効である。薄膜が先発のバルスレーザによる溶融中に、次発のバルスレーザを照射することにより、薄膜の溶融時間が延長され、かつ溶融速度も低減し、得られる結晶粒径が拡大する。

[0015] 本発明の半導体薄膜の製造方法は、このダブルパルス法において、図1に示すように、 n を1以上の整数とすると、 n 発目のバルスのエネルギー密度を E_n 、パルス幅を W_n 、 $(n+1)$ 発目のバルスのエネルギー密度を E_{n+1} 、 n 発目のバルスの長さ L_n と $(n+1)$ 発目のバルスの長さ L_{n+1} の照射間隔を t_n 、薄膜の微結晶化しきい値を E_u とすると、 $E_u > E_n + E_{n+1}$ 、 $t_n \leq 6W_n$ 、 $E_1 + E_2 + \dots + E_n + E_{n+1} > E_u$ の条件下でスキャン照射することにより、大粒径を有する半導体薄膜を大面積に渡り均質に形成できる。従って本発明により、高均一、高移動度を有する薄膜トランジスタ素子が大量に製造可能となる。

[0016] 上記本発明の基本的な構成を具体的に展開させた実施形態について、以下に説明する。

[0017] まず、本発明の半導体薄膜の製造方法の第1の実施形態について、図2-5を参照して説明する。[0018] ガラス基板1上に、カバードとしてシリコン酸化膜2が厚さ200nmとなるようにプラズマ化学気相成長 (PECVD) 法により形成され、その上に a -Si膜3を成膜した。成膜法としては、減圧化学気相成長 (LPCVD) 法、PECVD法、スパッタ法などが有るが、ここでは膜中にガスを含まないLPCVD法を用いた。膜厚は50nmとした(図5(a))。

[0019] 次に、膜厚50nmの a -Si膜3に、長軸方向が例えば100nm、短軸方向が10~20μmのディメンジョンを有する波長308nm、パルス幅(W1) 50nsのXeClレーザ光50を照射すると、微結晶化しきい値 E_u は470mJ/cm²である。ここで図2に示した2個の光源4、5を制御装置

(4)

6で同期させ、光素子7を通してチャップマン8内に設置されたガラス基板1の a -Si膜3にダブルパルス照射を行った。ダブルパルス照射条件としては、第1のレーザ光のエネルギー密度 (E_1) を400mJ/cm²、第2のレーザ光のエネルギー密度 (E_2) を240mJ/cm²、照射間隔 (t_1) を100nsとした($t_1 = 2W_1$)。

[0020] その結果、図3(a)に示すように、上記条件のダブルパルス照射を行うと、異方性を有する長円形状の粗大結晶粒10が形成され、この隣接領域は微結晶化領域9となる。粗大結晶粒10の粒径は長軸方向11で2.8μm、短軸方向12で1.2μmであった。本ダブルパルス照射条件を用いて、粗大結晶粒径以下の2.0μmのスキャンピッチ13でスキャン照射することにより、図3(b)に示すような、逆接成長した結晶粒領域16を得ることができ、このときのステータス作精度は、粒径と照射ピッチを考慮すれば0.7μm以下が要求される。

[0021] 一方、本実施形態の利点を説明するための比較例を図3(c)に示す。レーザ結晶化法を用いて、図3(c)に示すように、微結晶領域19の境界部には粒径0.8μmのほぼ等軸的な結晶粒20が形成された。本条件で逆接成長させるには、スキャンピッチを0.6μm以下とする必要があり、スループットは低下する。またステータス作精度は0.2μm以下が要求されるため、照射距離全域にわたって逆接成長した結晶粒を安定的に再現性良く得ることは難しい。

[0022] 次に、図4に、レーザ光のエネルギー密度 E_1 、 E_2 および t_1 を拡大させたときに得られる、異方性を有する粗大結晶粒の長軸方向の粒径を示す。 E_1 を E_u を超えるようにすると、 E_2 および t_1 の如何に関わらず、粒径拡大効果は小さい(図4(a))。これは E_1 により既に基板界面近傍の温度が、核発生が過度に抑制された温度に到達しているためであると考えられる。基板界面での核発生を過度に抑制しつつ、粒成長を促進させるために a -Si膜3の厚さ t_1 を溶融させて、粗大な結晶粒を形成するには、 E_1 を E_u 以下にする必要がある(図4(b)、(c))。また $(E_1 + E_2)$ が E_u 以下の場合、照射条件によっても、微結晶化せずに逆接成長が阻害されるという問題と、 a -Si膜3の厚さ t_1 が不足するために粒径拡大効果が小さくなるという問題がある。

[0023] 次に、本発明の半導体薄膜の製造方法の第2の実施形態について、図5(b)を参照して説明する。

[0024] ガラス基板1上にカバードとしてシリコン酸化膜2をPECVD法により100nm、続いてLPCVD法により a -Si膜3を75nmの膜厚に成膜した。 a -Si膜3に波長248nmでパルス幅

(W1; W2) 38nsのKrFレーザ光60を照射するときの E_u は500mJ/cm²である(図5(b))。ここで $E_1 = 380$ mJ/cm²、 $E_2 = 260$ mJ/cm²、 $E_3 = 200$ mJ/cm²、 $t_1 = 80$ ns、 $t_2 = 50$ ns、 $t_3 = 2$ 、 $1W_1$ 、 $t_2 = 1.3W_2$ 、の条件で照射したとき、粗大結晶粒の長軸および短軸方向の粒径は、それぞれ3.9μmおよび1.4μmとなり、長軸方向、短軸方向共に第1の実施形態よりも大きい粒径が得られる。従って、第1の実施形態よりも広いスキャンピッチでスキャン照射することが可能となり、ステータス作精度も、第1の実施形態よりも向上されることになる。

[0025] 次に、本発明の半導体薄膜の製造方法の第3の実施形態について、図5(c)を参照して説明する。

[0026] ガラス基板1上にシリコン酸化膜42をPECVD法により100nmの膜厚に成膜した後、同じくPECVD法により a -Si膜43を50nmの膜厚に成膜した。ここで、PECVD法による a -Si膜43は第1、2の実施形態による a -Si膜より多量の水素を含んでいるので、400℃のアニールを30分施し、 a -Si膜33の脱水処理を行った。 a -Si膜43に波長248nmでパルス幅(W1) 38nsのKrFレーザ光70を照射するときの E_u は460mJ/cm²である(図5(c))。KrFレーザ光70を a -Si膜43に、 $E_1 = 350$ mJ/cm²、 $E_2 = 200$ mJ/cm²、 $t_1 = 60$ ns、 $t_2 = 1.6W_1$ 、の条件で照射したとき、粗大結晶粒の長軸および短軸方向の粒径は、それぞれ2.5μmおよび1.2μmとなった。本実施形態では、PECVD法による a -Si膜を用いた場合において、第1、2の実施形態におけると同様の粗大結晶粒を得ようとするものであり、従って、第1の実施形態にほぼ近いスキャンピッチでスキャン照射することが可能となり、ステータス作精度も、従来よりは大幅に改善されることになる。

[0027] 以上説明した実施形態では、3つの例を紹介したに過ぎないが、発明者の経験から、本発明に用いる複数のパルスレーザの照射間隔 t_n はパルスレーザの幅との関係において、 $t_n \leq 6W_n$ の間隔を満たしていることが好ましく、一層望ましい間隔としては、 $W_n \leq t_n \leq 4W_n$ の間隔を満たしていることである。

[発明の効果] 上述のように、本発明の半導体薄膜の製造方法によれば、 a -Si膜に、前述の条件を満たす数のパルスレーザを照射することにより、長軸方向が短軸方向の2倍を超える粗大結晶粒が得られ、基板の広い範囲に渡って大きなスキャンピッチでスキャン照射することが可能となり、高いスループットが得られる。[0029] 又、前述の条件によるパルスレーザ照射によって粗大結晶粒が得られることにより、基板をパルス

(5)

8

レーザに対して移動させるステージ動作精度も、従来よりも大幅に緩和することができ、ステージの製造コストを大幅に下げることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体薄膜の製造方法の基本的な構成部分である相前後するパルスレーザの相互関係を示すパルス形状図である。

【図2】本発明の半導体薄膜の製造方法を表現するパルスレーザの照射装置及び被照射物の様子を模式的に示す構成図である。

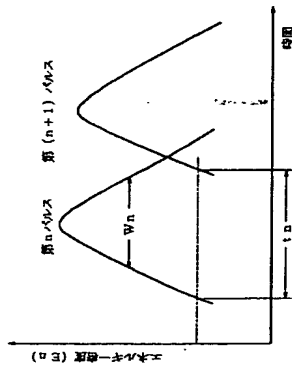
【図3】本発明の半導体薄膜の製造方法により得られる半導体薄膜の結晶状態を示す半導体薄膜の拡大平面図である。

【図4】本発明の半導体薄膜の製造方法において、パルスレーザ照射により得られる粗大結晶粒の長軸方向の粒径とパルスレーザ間隔との関係を、パルスレーザのエネルギー密度をパラメータとして示すグラフである。

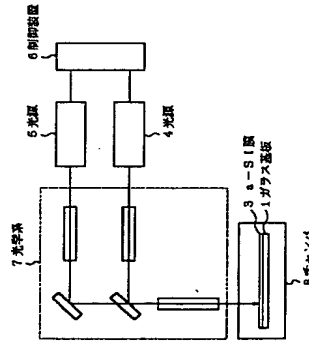
【図5】本発明の半導体薄膜の製造方法に用いられるパルスレーザの被照射物の様子を断面図である。

20

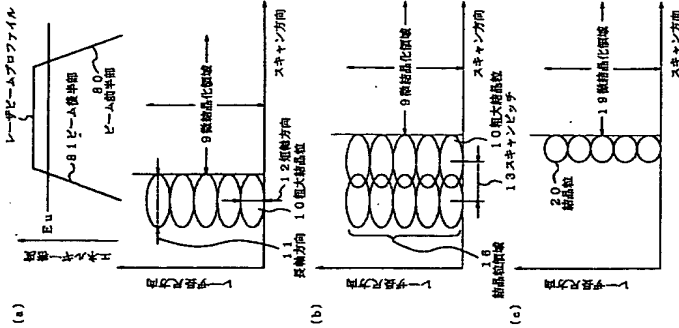
【図1】



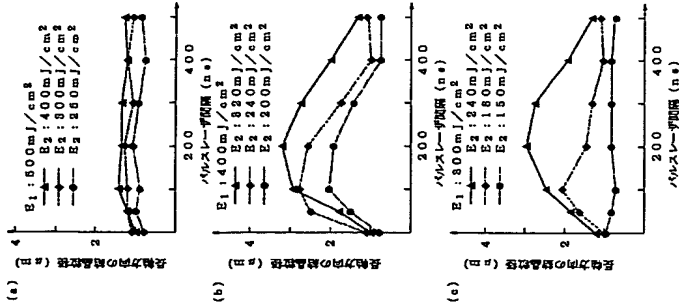
【図2】



【図3】



【図4】



(6)

(7)

【図5】

